

硅 Silicon ET-2060 – 硅光电探测器 >1.1 GHz 美国 EOT



产品描述

EOT 的<10 GHz 光电探测器包含 PIN 光电二极管，利用光伏效应将光功率转换为电流。当端接到示波器的 50 Ω 电阻时，可以测量激光的脉冲宽度。当端接到频谱分析仪的 50 Ω 电阻时，可以测量激光器的频率响应。EOT 的 <10 GHz 光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源。将同轴电缆插入光电检测器的 BNC 输出连接器并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 是操作所需的全部内容。

产品特点

占地面积小，内部电压偏置，直流至 2 GHz

产品型号

ET-2060

应用领域

监控调Q激光器的输出

监控锁模激光器的输出

核心参数

响应度	带宽
0.47 A / W@830 nm	>1.1 GHz

型号参数

选项

可提供外墙插入式电源

提供光纤耦合或自由空间选项

规格

型号	120-10011-0001 (ET-2030)	120-10028-0001 (ET-2040)	120-10133-0001 (ET-2060)	120-10134-0001 (ET-2070)	120-10034-0001 (ET-3000)	120-10050-0001 (ET-3010)
探测器材料	Silicon	Silicon	Silicon	Silicon	InGaAs	InGaAs
Rise Time/Fall Time 上升/下降时 间	<30 ps/<300 ps	<30 ns/<30 ns	<32 ps/<320 ps	3 ns/3 ns	<17 ps/<175 ps	<17 ps/<175 ps

响应度	0.47 A/W at 830 nm	0.6 A/W at 830 nm	0.47 A/W at 830 nm	0.56 A/W at 830 nm	0.9 A/W at 1300 nm	0.9 A/W at 1300 nm
电源	9 VDC	24 VDC	9 VDC	24 VDC	6 VDC	6 VDC
带宽	>1.2 GHz	>25 MHz	>1.1 GHz	>118 MHz	>2 GHz	>2 GHz
Active Area Diameter 有效面积直径	0.4 mm	4.57 mm	0.4 mm	2.55 mm	100 μ m	100 μ m
Dark Current 暗电流	<0.1 nA	<10 nA	<0.1 nA	<10 nA	<2.0 nA	<3.0 nA

Acceptance Angle (1/2 angle) 接受角 (1/2 角)	10°	60°	N/Aa	50°	20°	N/Aa
Noise Equivalent Power 噪声等效功率	<0.01 pW/√ Hz	<0.09 pW/√ Hz	<0.01 pW/√ Hz	<0.10 pW/√ Hz	<0.03 pW/√ Hz	<0.03 pW/√ Hz
Maximum Linear Rating Max. 线性额定值	CW current: 3 mA Pulse current: 3 mA	CW current: 2 mA Optical input: 3 mW	CW current: 3 mA Optical input: 3 mA	CW current: 2.5 mA Pulse current: 15 mA	CW current: 5 mA	CW current: 5 mA

Mounting (Tapped Holes) 安装 (螺纹 孔)	8-32 or M4	8-32 or M4	8-32 or M4	8-32 or M4	8-32 or M4	8-32 or M4
Output Connector 输出连接器	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC

产品规格可能会更改。所有产品均符合 RoHS 标准。

a 包括 FC 插座

特性曲线

